

Silicon-Diode

1S136

600V / 200mA

DATASHEET

OEM – Texas Instruments

Source: Texas Instruments Databook 1968/69

1S130, 1S131, 1S132, 1S134, 1S136, 1S138**Diffundierte-Siliziumdiode**

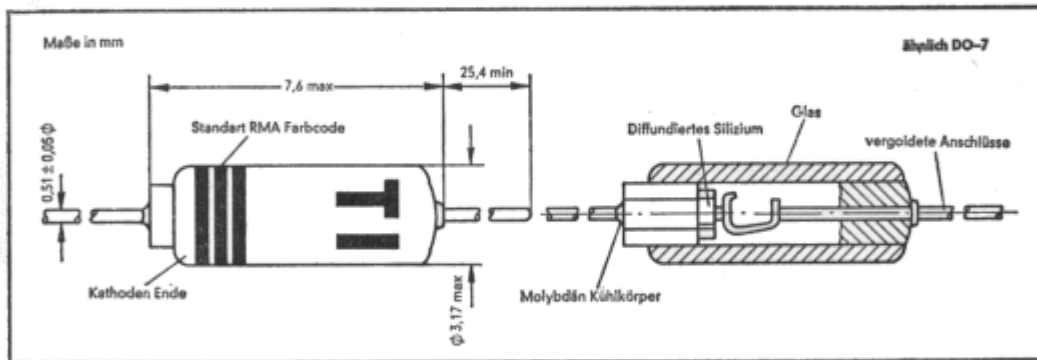
Preiswerte und hochwertige diffundierte Silizium-Diode
Ideal für kommerzielle Anwendung
Axiale Drahtanschlüsse

Mechanische Daten

Hermetisch geschlossenes Hartglasgehäuse.

Gewicht: etwa 0,2 g.

Die Gehäuseabmessungen entsprechen VASCA SO-7.

**Farbcode (beginnend von der Katodenseite)**

1S130	braun	orange	schwarz
1S131	braun	orange	braun
1S132	braun	orange	rot
1S134	braun	orange	gelb
1S136	braun	orange	blau
1S138	braun	orange	grau

Absolute Grenzwerte

	1S130	1S131	1S132	1S134	1S136	1S138	Einh.
Spitzensperrspannung von -65 °C bis $+100\text{ °C}$	50	100	200	400	600	800	V
Richtstrom von -65 °C bis $+25\text{ °C}$	200	200	200	200	200	200	mA
Richtstrom bei 100 °C	100	100	100	100	100	100	mA
Periodischer Spitzenstrom bei 25 °C	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	A
Periodischer Spitzenstrom bei 100 °C	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	A
* Stoßstrom 1 s bei 50 Hz und 25 °C	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	A
* Stoßstrom 1 s bei 50 Hz und 100 °C	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	A
Umgebungstemperatur	-65 °C bis $+100\text{ °C}$						

* Die Spannung muß am Ende der Impulsperiode abgeschaltet werden.
Diode kann davor voll belastet werden.

Absolute Grenzen

Maximaler Reststrom bei Durchbruchspannung und 25 °C Umgebungstemperatur	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	μA
Maximale Durchlaßspannung bei $I_F = 200\text{ mA}$ und 25 °C Umgebungstemperatur	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	V

Typische Parameter

	typ	max	Einh.
Reststrom bei Durchbruchspannung und 100 °C Umgebungstemperatur	10	50	μA
Durchlaßspannung bei $I_F = 1\text{ mA}$ und 25 °C Umgebungstemperatur	0,55	0,60	V

